66003

中部シンクロトロン光利用施設(仮称)計画

高嶋圭史^{1,2},加藤政博^{3,1},渡邉信久^{1,2},保坂将人^{1,2}, 竹田美和^{1,2},山根 隆²,曾田一雄²

1名古屋大学小型シンクロトロン光研究センター〒464-8603名古屋市千種区不老町2名古屋大学大学院工学研究科〒464-8603名古屋市千種区不老町3分子科学研究所極端紫外光研究施設〒444-8585岡崎市明大寺町字西郷中38

要 旨 名古屋大学では,平成3年よりX線利用を主な目的とした比較的小型のシンクロトロン光施設建設の計画を進めてきた。平成15年からは,愛知県の進める「知の拠点」計画の主要施設の一つとして,愛知県や中部地区の大学,研究所,産業界と協力して計画の具体化のために検討を行っている。これまでの計画の経緯や,予定している光源加速器, ビームラインについて報告する。

1. はじめに

名古屋大学のシンクロトロン光施設建設計画は、平成3 年に築島隆繁先生、原田仁平先生、早川幸男学長(当時) 間で検討を開始されたことが事の始まりである¹⁾。その後 平成6年1月に水谷宇一郎先生と本稿の著者の一人であ る竹田の二人を世話人としてNSSR (Nagoya University Small Synchrotron Radiation Facility)設置促進委員会が 発足した。名古屋大学のシンクロトロン光ユーザーには工 学研究科所属の方が多いこともあり、当初より、硬X線 が使える小型のシンクロトロン光施設によって、工学・産 業への応用を促進することを表明していた。この計画は、 さらに、シンクロトロン光施設を中心として、周辺装置や 研究・実験支援までを含む「光科学ナノファクトリー」構 想へと発展してきた。

光科学ナノファクトリー構想は、「ものづくり」を念頭 に置いた計測・分析拠点として、シンクロトロン光施設を 中心に周辺装置、支援組織、産学連携組織を備えた施設の 実現を目指している。その中で光源加速器には最先端の性 能を求めるというよりも、むしろビームラインの配置やエ ンドステーションとその周辺装置に大きな特徴を持った施 設として計画をすすめてきた。すなわち、クリーンルーム や、ガス雰囲気中・有機溶媒中・電磁場環境中などの実使 用環境下にある試料の測定や観察を行うための周辺装置や 設備を建設当初より備えること、SEM、TEM、X線装置 等の各種高レベルの分析装置を配置することで通常の実験 室ではできないレベルの多面的な計測や分析を行い、一連 の研究がこの施設内で完結できることを想定していた。ま た、ハード面だけでなくソフト面についても、小型である ことを利用して,たとえば試行錯誤を繰り返しながらの長期的研究・開発が可能な柔軟性のある利用方法や運営体制 の可能性を検討してきた。ソフト面を充実させることは, 従来シンクロトロン光が使用されてきた先端的研究だけで なく,産業界との連携を進め,潜在的なユーザーを掘り起 こし,利用者と利用分野を広げることに繋がる。

一方,愛知県では、地域の科学技術振興策としての「科 学技術交流センター」構想の強化のため、平成15年に行 われた構想の見直しに際して、シンクロトロン光施設を構 想の目玉として導入することの検討を開始した。この結 果、次世代ものづくり技術の創造・発信を図る「知の拠点」 計画として、ナノテクノロジー、IT、バイオテクノロ ジーを基盤技術とした研究開発・応用への取り組みへと展 開してきた。名古屋大学が提案してきた光科学ナノファク トリー構想は、これらの分野に多角的な計測分析データを 提供できるものであり、産業界からの要望に応える地域共 同利用施設として、「知の拠点」に最適な施設として期待 されている。このため、現在、愛知県、産業界、大学、研 究機関が連携してシンクロトロン光施設計画実現のための 活動を行っている。

今年4月には名古屋大学に全学附属施設としての「小型シンクロトロン光研究センター」が発足した¹⁾。セン ターは、光源部門、ビームライン部門、分析・計測部門で 構成されており、産・学・行政の連携施設としての「中部 シンクロトロン光利用施設(仮称)」の設計・建設及び運 営において、学術と技術面を中心に、指導的な役割を担 う。また、名古屋大学をはじめ東海地区の厚いユーザー層 が自らの研究を加速度的に展開するとともに新規ユーザー や産業界への学術的・技術的支援を行う予定である。

2. 光源加速器

2.1 概要

現在ほとんどのシンクロトロン光源用電子蓄積リングで は常伝導の電磁石が使用され、その典型的な磁場強度はお よそ1T(テスラ)である。このため10keVを超えるよ うな硬X線領域で十分な強度のシンクロトロン光を生成 するには、2.5 GeV 程度以上の電子エネルギーが必要とな る。このような高エネルギーの加速器は必然的に周長が長 くなり,建設コストも高額になる。実際,日本国内におい て多数のシンクロトロン光源が稼動している現在でも10 keV 超のX線を十分な強度で多数のビームラインに供給 できる施設は, SPring-8 と Photon Factory の 2 つの施設 に過ぎない。シンクロトロン光利用者の大半はX線を利 用するといわれており,中部シンクロトロン光利用施設に 関するアンケート調査の結果でもX線領域での利用者が 65%以上ある。このため、電子エネルギーを比較的低く 抑えながら10 keV 超の X 線の利用を可能にするため、以 下に述べるように蓄積リングの偏向電磁石の一部を超伝導 電磁石とする。この方法は、ローレンスバークレー研究所 の Advanced Light Source に導入されているが²⁾,中部シ ンクロトロン光利用施設のように周長の短い小型リングに おいて,多数のX線ビームラインを引き出す方法として 有効であるため採用した。

中部シンクロトロン光利用施設は,大学や研究所での研 究・教育だけでなく産業界との連携を目指した施設であ る。その中核の光源加速器の設計にあたっては以下の点を 考慮している。

- (1) 地域の中核施設として適正規模であること
- (2) コストパフォーマンスに優れていること
- (3) 10 keV 以上の X 線を10本以上のビームラインに供給できること
- (4) 挿入光源を設置可能であること
- (5) トップアップ入射による一定電流運転が可能である こと
- (6) 既存の技術で無理なく実現可能であること
- (7) 運転維持管理が容易であること

(1)については、具体的にどの程度を適正規模というの か、判断は分かれるところであるが、全国共同利用施設で ある高エネルギー加速器研究機構の Photon Factory(周 長187 m)と比べて十分に小さいことをひとつの目安とし た。すなわち周長50 mを大幅に上回らないことを目標と した。(3)については、中部地区のシンクロトロン光の需要 がX線領域に多いことを考慮した。(4)は、極紫外・軟X 線領域での高輝度光の需要、あるいは、より短波長のX 線の要求に応えるためにアンジュレータや超伝導ウィグラ の導入の余地を残しておく、というものである。(5)は、既 に一部の先進的なシンクロトロン光施設で導入されている トップアップ運転を比較的早い段階から導入し、常に一定

の質の光を供給するためである。(6)については、既存施設 の加速器研究者の協力を得ながら最新の加速器技術を導入 するものの,基本的には,実績のある技術を中心にして, 開発的要素を極力抑え、建設及び立ち上げ調整を短期間で 終了し、可能な限り早く定常運転を開始するためである。 また,(7)については,建設期,初期運転期にはできるだけ 多数の加速器研究者・技術者の参加を求めるが、その後の 定常運転期は、比較的小さな組織で運転維持管理できるよ う、設計段階から配慮するべきであると考えた。このた め、加速器制御システムは汎用的なものを導入するととも に、運転の自動化を建設後の早い段階で進めていく。また、 (1)および(2)とも関係することであるが、定常の運転状態で のランニングコストを抑えるため電子エネルギーは比較的 低い値とし, 蓄積リングとブースターシンクロトロンの電 磁石数、電磁石形状の最適化を行って電磁石で消費する電 力を抑える。

上記のような考え方をもとに設計した加速器の主要パラ メタを Table 1に、また、加速器及び実験ホールの配置案 を Fig. 1に示す。最大の特徴は蓄積リングの全12台の偏向 電磁石中4台を超伝導としている点にある。これによ り、小型・低エネルギーでありながら10 keV 超のX線を 10本以上のビームラインに供給できるようになってお り、大型施設並みのX線発生能力を備えている。蓄積リ ングは、ビームエネルギー1.2 GeV、周長62.4 m、エミッ タンス53 nm-rad であり、計4本の直線部を有する。直線 部長は約2.8 mであり、1箇所はビーム入射、1箇所は高 周波加速、残り2箇所は挿入光源に利用する。ビーム計

 Table 1
 Main parameters of accelerators

・電子蓄積リング	
蓄積電子エネルギー	1.2 GeV
蓄積電流	300 mA 以上
周長	62.4 m
偏向電磁石	
常伝導偏向電磁石(1.4 T)	偏向角39°×8台
超伝導偏向電磁石(5T)	偏向角12°×4 台
加速周波数	500 MHz
自然エミッタンス	53 nm-rad
ラティス構成	Triple Bend セル4回対称
直線部	$2.8 \text{ m} \times 4$
•入射器	
1.2 GeV ブースターシンクロトロ	ン
電子エネルギー	1.2 GeV
偏向電磁石磁場	1.1 T
周長	38.4 m
加速周波数	500 MHz
加速繰り返し	1 Hz
ライナック	
電子エネルギー	50 MeV
パルス幅	$1\mu \text{sec}$
加速繰り返し	1 Hz



Fig. 1 Layout of accelerators and beamlines.

測用の機器もこれらの直線部に分散して配置する。実験 ホールに隣接する建物内にフルエネルギーの入射器を設置 する。運転の容易さを考慮し入射器はブースターシンクロ トロンとする。トップアップ運転の導入に備え,ブース ターシンクロトロンのエネルギーは1.2 GeV のフルエネル ギーとする。蓄積リングへの入射をフルエネルギーで行う ことは,蓄積リングでの加速を避けることにより,初期の 立ち上げ調整が容易になるという利点もある。前段入射器 はエネルギー50 MeV のライナックとする。ブースターシ ンクロトロンとライナックを納める入射器室の床面は,蓄 積リングを設置する実験ホールの床面よりも3mほど低 い半地下とし,入射路がビームライン設置の妨げにならな いように計画している。これは放射線防護の面からも有用 である。

Fig.1に示すように蓄積リング及び実験ホールはおよそ 81m×66mの建物内に配置している。実験エリアの外側 に加速器コントロール室や試料準備室,クリーンルームな どを配置し,一部クリーンルームにはシンクロトロン光を 直接導くこととしている。電磁石電源類など加速器運転用 機器は蓄積リング内側の空間に設置する。受電設備,冷却 水設備,空調設備なども同じ建物内に設置する。

2.2 電子蓄積リング

電子蓄積リングの機器配置を Fig. 2(a) (b) に,主要パラ メータを Table 2 に示す。この蓄積リングでは超伝導電磁 石,常伝導電磁石,さらに 2 台の挿入光源が実装される。 Fig. 2(b) において,QF および QD はそれぞれ電子ビーム を収束させるための 4 極電磁石 (Focusing Quadrupole magnet) と発散させるための 4 極電磁石 (Defocusing Quadrupole magnet) を示している。また S は 6 極電磁石 (Sextupole magnet) である。数字を付けているのは磁場 の強さの違う電磁石を区別するためである。

加速器の電磁石配列(ラティス)の設計は、電子ビーム



Fig. 2(a) Layout of storage ring.



Fig. 2(b) Layout of a cell of storage ring.

の品質や、挿入光源やビームラインなどの配置を決定づけ るものであり、加速器を検討する上で最も基本的な部分で ある。電子蓄積リングのラティスは、通常、ある基本構造 を繰り返すことで構成され、この基本構造はセルと呼ばれ る。シンクロトロン光源で広く用いられているセルには Double Bend Achromat (DBA) セルあるいは Triple Bend Achromat (TBA) セルなどがある。一般にセルの数を増 やすとエミッタンスを小さくすることができるため、いわ ゆる第3世代シンクロトロン光源の多くでは比較的電子 ビームのエネルギーが低いものでもセル数は10以上とな っている。一方で、セル数が多くなると蓄積リングの周長 が長くなり建設コストが上がる。

本施設では,Triple Bend すなわち偏向電磁石3台を含 むセルを4回繰り返すことで蓄積リングを構成すること とした。通常は各偏向電磁石の偏向角は同じにするが,本 計画では3つの偏向電磁石の中央のものを超伝導電磁石 とし,それ以外を常伝導電磁石とする。

電磁石1台あたりの偏向角は常伝導電磁石で39°,超伝 導電磁石で12°と異なる値にしてある。これは超伝導電磁 石について実績重視で設計した結果得られた偏向角を採用 したためである。このラティス案では合計4台の超伝導 偏向電磁石が設置される。後述するように1つの超伝導 偏向電磁石からは3本のビームラインに光を取り出すこ とが可能であるため,合計では最大12本のX線ビームラ

	低エミッタンスモード	中エミッタンスモード
ビームエネルギー	1.2 GeV	
周長	62.4 m	
蓄積電流	>300 mA	
エミッタンス	53 nm-rad	97 nm-rad
エネルギー広がり	$8.41 imes 10^{-4}$	
ラティス構造	Triple bend セル4 回対称	
挿入光源用直線部	2.8 m×1本, 2.48 m×1本	
ベータトロン振動数	(4.72, 3.23)	(4.72, 3.23)
モーメンタムコンパクションファクター	0.022	0.023
放射損失	86.2 keV/turn	
周回周波数	4.804 MHz	
RF 周波数	500 MHz	
ハーモニック数	104	
RF 電圧	500 kV	
RFバケットハイト	0.926%	
ダンピングタイム	(5.80, 5.79, 2.90) msec	
(βx, βy, ηx)@直線部	(29.9, 3.20, 1.2) m	(26.6, 3.49, 0.7) m
(β x, β y, η x) 最大値	(29.9, 10.5, 1.2) m	(26.7, 11.0, 0.7) m

Table 2Parameters of storage ring

インが建設可能となる。

さらに数多くの偏向電磁石を超伝導とすることも可能で あり、その場合にはさらに数多くのX線ビームラインが 建設できることになる。しかし、この場合、放射損失によ る電子ビームのエネルギー低下が非常に大きくなり、それ を補償するための高周波加速系の能力を高める必要がある が、これは建設コストの増大をもたらす。また、超伝導電 磁石の増加そのものも建設コストを押し上げる。あるい は、セル数を増やすことでエミッタンスはさらに小さくで きるが、周長が大きくなるため建設コストは増大する。今 回採用した4セル案は、最小限の建設コストで必要十分 なX線ビームライン数を確保するように最適化されたと 考えている。

蓄積リングの光学関数を Fig. 3 に示す。Fig. 3(a) は水平 および垂直方向のベータ関数の平方根であり, Fig. 3(b)は エネルギー分散関数である。それぞれ蓄積リングの4分 の1周における値を示している。ベータ関数の平方根は 蓄積リング内を周回している電子の広がりに比例する量で あり、超伝導偏向電磁石(Superbend)の位置で水平方向 のベータ関数の平方根が他の部分に比べ小さくなるように 調整している。これは、電子の水平方向の広がりを抑える ことで超伝導偏向電磁石の電子ビームへの悪影響を抑える ためである。Fig. 3(b)のエネルギー分散関数は, 蓄積リン グ内を周回している電子のエネルギーの相対的なずれに対 する水平方向の位置のずれを表す量である。1980年代に 建設された第2世代光源,90年代の第3世代光源では直 線部のエネルギー分散を消去した、いわゆるアクロマート ラティスが広く採用されているが、2000年代に入り建設 が進められている,いわゆる新第3世代光源では,アク



Fig. 3 Optical functions of 1/4 of storage ring. Panel (a) shows the square root of the horizontal (solid line) and the vertical (dashed line) beta functions. Panel (b) shows the horizontal dispersion function.

ロマートな条件を破ることで低エミッタンス化を図る場合 が増えている。中部シンクロトロン光利用施設における蓄 積リングのラティス設計でも,限られた周長・セル数の制 約のもとで可能な限りエミッタンスを小さくするために直 線部のエネルギー分散を消去しないラティスを採用してい る。直線部のエネルギー分散を1.2 m と大きく取り,エミ ッタンスを最小にした低エミッタンスラティスと,直線部 の分散を0.7 m と比較的小さくした中エミッタンスラティ スを用意している。後者は直線部のエネルギー分散が大き いことが何らかの形で光源性能に影響を与える場合のため



Fig. 4 Flux of synchrotron radiation from bending magnets and wigglers. $(I_b = 300 \text{ mA})$

Table 3	Parameter	of	variably-polarizing	undulator
---------	-----------	----	---------------------	-----------

磁石列方式	APPLE-II 型
周期長	60 mm
周期数	33
残留磁束密度	1.36 T
磁石ブロック	x: 40 mm, y: 60 mm
最小磁極間隙	28 mm
Max. K Parameter	2.90 (Hor.)
	1.65 (Ver.)
	1.43 (Hel.)

に用意した。Table 2 には中エミッタンスモードでの蓄積 リングのパラメータも示している。

超伝導および常伝導偏向電磁石からのシンクロトロン光 のスペクトルを Fig. 4 に示す。超伝導電磁石からのシンク ロトロン光は臨界エネルギー4.8 keV であり10 keV 以上 のX線も十分な強度で利用できる。一方,常伝導偏向電 磁石からのシンクロトロン光はミリ波・テラヘルツ波から 5 keV 程度の軟X線にいたる領域で十分な強度を持つ。 挿入光源として7Tあるいは10T程度の超伝導ウィグラ を導入することで30 keV 以上のより高エネルギー・短波 長のX線を生成することもできる。また,適切な周期長 のアンジュレータを設置することで,真空紫外から軟X 線の領域で高輝度シンクロトロン光を発生することができ る。アンジュレータのパラメタ案およびスペクトルをそれ ぞれ Table 3 および Fig. 5 に示す。

2.3 超伝導偏向電磁石

小型でありながらX線領域のシンクロトロン光を発生 させるため5T超伝導偏向電磁石を蓄積リングの偏向電 磁石の一部に使用する。3本のビームラインを設置する場 合,超伝導偏向電磁石内での電子の偏向角12°のうち,電 子の偏向角が3°,6°,9°の位置からのシンクロトロン光を 取り出す。超伝導偏向電磁石の詳細は検討中であるが,現



Fig. 5 Brilliance of synchrotron radiation from an undulator. ($I_b = 300 \text{ mA}$)

Table 4 1	Main	parameters	of	а	superbend
-----------	------	------------	----	---	-----------

鉄心形式	C 型
ギャップピーク磁場	5T以上
偏向角	12° (1.2 GeV)
コイル電流密度 (オーバーオール)	127 A/mm ²
電流	150 A
超伝導線	NbTi/Cu
鉄心材料	SUY (電磁軟鉄)
ウォームボアギャップ	50 mm
鉄心ポールギャップ	80 mm
ポール形状 (ビーム方向,水平方向)	(70 mm, 180 mm)
外形寸法(軸方向,高さ,幅)	(840 mm, 2000 mm, 1136 mm)
全体重量	3500 kg
GM 方式小型冷凍機	$45\;W$ (50 K), 1.5 W (4.2 K)



Fig. 6 Layout of superconducting bending magnet.

在の案を Table 4 及び Fig. 6 に示す。

加速器用電磁石では7T程度のものが超伝導ウィグラ として稼動実績があるようであり、10Tのものも蓄積リ ングに組み込んでテストが行われている³⁾。しかし、超伝 導偏向電磁石は蓄積リングの運転に必須の偏向電磁石の一 部であり、これが正常に機能しないと加速器の運転自体が 停止してしまうことを考慮し、安定に稼動している実績の ある5Tを磁場強度として選択した。

超伝導偏向電磁石のサイズは、磁場の染みだしを防ぐた めのフィールドクランプを含めたビーム進行方向の長さが 840 mm,幅1136 mm,高さ2000 mmである。鉄心形状 は、真空ダクトのベーキング、真空ダクトもしくは電磁石 の交換の可能性を考慮してC型とする。冷却には、コス トとメンテナンス性を考えて小型冷凍機を使用し、それぞ れの超伝導電磁石に1台ずつ配置する。冷凍機は2ス テージタイプとし、第1ステージで熱シールドの冷却、 第2ステージで液体へリウムの蒸発ガスを冷却する。液 体へリウムタンクをクライオスタット内に配置し、伝熱板 を介してコイルを冷却する。冷凍機の故障や停電時でも、 液体へリウムを定期的に補充することによって運転が可能 な構成とする。数%程度予想される磁場強度の個体差は個 別電源励磁とすることで対処する予定であり、磁場測定の 精度で補正が可能である。 対してプロットしたものが **Fig. 7** である。磁場強度はピー ク部分で5T である。シンクロトロン光の取り出し角度 3°および 9°の位置はピーク部分より約45 mm 離れている が,磁場強度は4.3T 以上である。

超伝導偏向電磁石の磁場強度を電子ビームの進行方向に

Fig. 8に超伝導偏向電磁石からの放射光取り出しポート 案を示す。超伝導偏向電磁石の偏向角は12°と通常の偏向 電磁石よりも小さく,ここから3本のビームラインを取 り出すためには,下流にある電磁石との干渉を避けて放射 光取り出しの基幹部を作製する必要がある。

超伝導偏向電磁石による6極磁場成分の大きさは,3次 元磁場計算によるシミュレーションの結果より,B"L= 29.8 T/m である。これは蓄積リングに配置予定の6極電 磁石により十分に補正可能な値である。また,6極成分補 正後のダイナミックアパーチャーは Fig.9に示すとおり, 入射蓄積に十分な大きさが得られている。



Fig. 7 Magnetic field of superbend along beam axis.



Fig. 9 Dynamic aperture after chromaticity correction. Red line shows the aperture for electrons with designed energy. Blue and green lines show the apertures for the electrons with the energy spread of $\pm 10 \sigma_{\rm E}$.



Fig. 8 Channel from superbend.



Fig. 10 Layout of booster synchrotron and linac.

2.4 入射器

入射はフルエネルギー,すなわち蓄積リングの運転エネ ルギーにまで加速された電子ビームを直接入射するものと する。蓄積リングでのビーム加速が不要となることから, 立上調整の時間の短縮が期待できる。また,いわゆるトッ プアップ入射が可能となる。トップアップ運転は,入射を 頻繁に繰り返すことで蓄積ビーム電流値を概ね一定に保つ 技術であり,既にいくつかのシンクロトロン光源で導入さ れている加速器技術である。従来は数時間ないし数10時 間ごとに数10分程度かけてビームを入射していたが,ト ップアップ運転では,数分毎にごく短い時間入射を行うこ とで,入射による利用実験の中断を最小限にし,また,蓄 積ビーム電流を概ね一定に保つことでビームライン光学系 の安定性を高め,常に同じ質で安定な光を供給できるため 実験結果の解析精度も飛躍的に高めることができる。

入射器には運転の容易さを考慮し、1.2 GeV のシンクロ トロンを採用する。シンクロトロンの RF 周波数は蓄積リ ングと同じ500 MHz とする。前段入射器は50 MeV のラ イナックとする。ライナックはシンクロトロンへのシング ルバンチ入射が可能なものとする。50 MeV の電子エネル ギーを1.2 GeV まで加速するためブースターシンクロトロ ンを用いる。ブースターシンクロトロン及びライナックの 機器配置を Fig. 10 に、主要パラメタを Table 5 に示す。

ブースターシンクロトロンは可能な限りコンパクトにす ることを目標に設計した。ラティスは、収束4極電磁石 と発散4極電磁石を、偏向電磁石を挟んで交互に配置し た、いわゆる FODO セルである。なお、高周波加速空 胴、入射用のパルス電磁石群を設置するためのスペースと して、収束4極電磁石(QF)のセクションに1m程度の フリースペースを計6箇所設けてある。高周波加速空胴1 台、入射用セプタム電磁石、出射用セプタム電磁石、入射 用キッカー電磁石3台、出射用高速キッカー電磁石1 台、さらにスクリーンモニタ3台、ビーム電流モニタ1 台、チューンモニタ用 RFKO 装置及びストリップライン 型ビーム信号検出器を1台ずつ設置する。

ライナックは電子ビームを生成しブースターシンクロト

 Table 5
 Parameters of booster synchrotron and linac

ブースターシンクロトロン	
ビームエネルギー	1.2 GeV
偏向電磁石磁場強度(1.2 GeV)	1.1 T
周長	38.4 m
RF 周波数	$500 \mathrm{~MHz}$
繰り返し	1 Hz
入射エネルギー	50 MeV
最大エネルギー	1.2 GeV
ベータトロン振動数 (H, V)	(2.25, 1.25)
モーメンタムコンパクションファクター	0.2265
エミッタンス(1.2 GeV)	688 nm-rad
エネルギー広がり(1.2 GeV)	$5.01 imes 10^{-4}$
RF 周波数	$500 \mathrm{~MHz}$
ハーモニック数	64
RF 電圧	500 kV
放射損失 (1.2 GeV)	51.9 keV/turn
RF バケットハイト (1.2 GeV)	0.39%
電流	20 mA
ライナック	
ビームエネルギー	$50 { m MeV}$
電流	100 mA
繰り返し	1 Hz
RF 周波数	2856 MHz
エネルギー広がり	$\sim 1\%$
規格化エミッタンス	25×10^{-6} m-rad
パルス長	$\sim 1\mu{ m sec}$

ロンへの前段加速を行う。加速エネルギーはブースターシ ンクロトロンが十分に安定に動作できる50 MeV を選ん だ。加速の主周波数は、多くのライナックに用いられ要素 技術が確立されているSバンドと呼ばれる2856 MHz を 用いる。また、グリッドパルサーを用いることでブース ターシンクロトロンへの電子ビームのシングルバンチ入射 が可能である。

3. ビームライン

中部シンクロトロン光利用施設は、工業材料評価や試験 研究といった産業界の利用を重視しており、その実現のた め、当初から建設・整備されるビームラインとして Table 6に示す6本が検討されている。これらのうち硬X線を 利用するビームラインは超伝導偏向電磁石ビームラインに 設置される。

表中1,2,3のビームラインは20 keV (ウイグラにより さらに高エネルギーをカバーすることも計画されている) から低エネルギーのすべての元素をカバーできる XAFS 測定ラインを揃えるものである。これにより,工業材料で 軽元素材料が重要性を増してきている現状に対応すること ができる。また,光電子分光も様々な材料開発において重 要性が増しており,アンジュレータ・ラインとして設置す

			51		
	ビームライン名	測定手法	エネルギー範囲	光源	予定される光学系
1.	材料化学状態 • 構造分析 I	硬 X 線 XAFS	5–20 keV	Superbend	CM, DXM, RFM
2.	材料化学状態•構造分析Ⅱ	軟 X 線 XAFS	1–6 keV	Bending Magnet	CM, DXM, RFM
3.	材料化学状態・構造分析Ⅲ	真空紫外分光	0.03–1.5 keV	Undulator	VIAM
		光電子分光			
4.	有機•高分子材料分析	小角散乱	5–20 keV	Superbend	TM, DXM
5.	総合材料評価I	X 線回折	5–20 keV	Superbend	VCM, SDXM, VRFM
6.	総合材料評価Ⅱ	蛍光 X 線分析	5–20 keV	Superbend	VFM, ASXM
		反射率測定			

 Table 6
 Beamlines for an early phase

§ CM: collimation mirror, DXM: plane 2 crystal monochromator, RFM: refocusing mirror, TM: toroidal mirror, VIAM: variable-included-angle Monk-Gillieson mounting monochromator, VCM: vertical collimating mirror, SDXM: sagittal focusing 2 crystal monochromator, VRFM: vertical refocusing mirror, VFM: vertical focusing mirror, ASXM: asymmetric 1 crystal monochromator.

る計画である。有機・高分子材料では小角散乱の有用性が 急速に認識され他施設でも設置されてきているが,独自の カメラ長と小角/超小角/広角をカバーできる柔軟性の高い 装置と広い実験スペースを用意する予定である。総合材料 評価ビームラインでは,平行性が高く波長可変の容易な ビームラインと,非対称ヨハン型分光結晶を用いた微小集 光で光束密度の高いビームラインを並列して設置し,か つ,使いやすいハード設計とソフトを用意する予定である。

さらに、これらのビームラインでは測定環境を企業等で の実際の開発環境に合せることを可能とすることが望まれ ており、様々なガス雰囲気中や温度・圧力にも柔軟に対応 することが検討されている。

また,当初計画の6本の他,タンパク質結晶構造解析 用ビームラインやナノ加工(LIGA)用ビームライン,赤 外分析用ビームラインも段階的に整備される予定である。 さらに,特定の企業が自社専用のビームラインを建設して 使用することも可能であり,そのための運用の枠組みも検 討中である。

なお、シンクロトロン光施設は、愛知県が「知の拠点」 計画において建設・整備を予定している「科学技術交流セ ンター(先導的中核施設)」に隣接する形で計画が検討さ れており、先導的中核施設に整備される研究開発機器や研 究者との有機的な連携によって、大企業のみならず中堅・ 中小企業の研究開発にも資することが期待されている。利 用時間の配分についても、学術的価値の評価のみにかたよ らず、企業の測定ニーズに柔軟に応じる高性能な汎用機器 としての位置付けで対応される予定である。建設予定の ビームラインについて、中部地区の産業界(愛知県が実施) と大学(名古屋大学小型シンクロトロン光研究センターが 実施)にアンケート調査を行い、ユーザーのニーズの把握 を行っている。産業界、大学ともに十分な利用ニーズが見 こまれており、地域の中核的研究拠点として機能すること が期待される。

4. まとめ

名古屋大学が提唱してきた,小型シンクロトロン光施設 を中心とした「光科学ナノファクトリー」構想は,愛知県 の「知の拠点」計画と一体となり,中部シンクロトロン光 利用施設として実現されようとしている。「知の拠点」計 画予定地は,名古屋市の都心部から東へ約20 km に位置す る愛・地球博の長久手会場に隣接しており,東部丘陵線 (リニモ)や東海環状自動車道により交通の便がよい場所 である。中部シンクロトロン光利用施設は,愛知県の予定 している先導的中核施設とともに中部地区における計測・ 分析拠点として,大学や研究所における基礎的研究,教育 はもとより,産業界における実用を目指した研究に対応で きる施設として,早期に実現するための検討が進められて いる。建設が決定した場合,その4年後には供用が始ま っているように整備を進めていく予定である。

謝辞

高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所の谷本 育律氏,宮内洋司氏,浅岡聖二氏には本計画の真空系, ビームライン基幹部等の検討に際して非常に多くのご協力 を頂いており、この場をお借りしてお礼申し上げます。愛 知県,産業界,科学技術交流財団,県内の大学等研究機関 の方々から構成される「小型シンクロトロン光利用施設」 具体化ワーキンググループのメンバーの方々には、計画の 実現に向けて多くの困難な問題の解決に当たって頂くとと もに有益なご助言を賜りここに深謝致します。また、高エ ネルギー加速器研究機構加速器研究施設の堀洋一郎氏、高 輝度光科学研究センターの佐々木茂樹氏、九州シンクロト ロン光研究センターの江田茂氏,兵庫県立大学の内海裕一 氏,分子科学研究所の繁政英治氏には名古屋大学小型シン クロトロン光研究センターの特任あるいは客員教員として 多くのご助言を頂きありがとうございます。最後に、これ まで名古屋大学においてシンクロトロン光施設建設計画に 携わって頂いた方々、現在も関わって頂いている多くの方 々に感謝致します。特に小型シンクロトロン光研究セン ター協力教員の方々には多大なご協力頂いており,心より 感謝致します。

参考文献

- 1) 高嶋圭史:放射光, Vol. 20, No. 3, 197 (2007).
- D. Robin et al.: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 538, 65–92 (2005).
- 3) K. Soutome et al.: Proceedings of the 2003 Particle Accelerator Conference, 250–252 (2003).

高嶋圭史

名古屋大学小型シンクロトロン光研究センター・准教授 E-mail: takasima@numse.nagoya-u.ac.jp

専門:加速器

1998年3月広島大学大学院理学研究科博士課程修了,博士 (理学)。1998年名古屋大学工学研究科助手,1999年分子科学 研究所助手,2003年名古屋大学工学研究科助手を経て,2006年6月より現職。

加藤政博

自然科学研究機構分子科学研究所極端紫外光研究施設・教授 E-mail: mkatoh@ims.ac.jp

専門:加速器、ビーム物理学

[略歴]

1986年東京大学大学院理学系研究科物理学専門課程中退,理 学博士。高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所助 手,分子科学研究所助教授を経て,2004年より現職。2007年6 月現在,分子科学研究所分子制御レーザー開発研究センター教 授(併任),総合研究大学院大学物理科学研究科教授(併任), 名古屋大学大学院工学研究科客員教授,高エネルギー加速器研 究機構物質構造科学研究所客員教授。

渡邉信久

名古屋大学小型シンクロトロン光研究センター・教授 E-mail: nobuhisa@nagoya-u.jp 専門:蛋白質結晶学

[略歴]

1989年3月筑波大学大学院博士課程物理学研究科修了。1989 年4月日本学術振興会特別研究員,1990年1月高エネルギー 物理学研究所放射光実験施設助手,1999年10月北海道大学大 学院理学研究科助教授。2007年6月より現職。

保坂将人

名古屋大学小型シンクロトロン光研究センター・准教授 E-mail: m-hosaka@nucl.nagoya-u.ac.jp 専門:加速器

[略歴]

1994年東北大学理学研究科博士課程修了,博士(理学),分子 科学研究所極端紫外光研究施設を経て2006年11月より現職。

● 著 者 紹 介 ●

竹田美和

名古屋大学小型シンクロトロン光研究センター・教授,セン ター長

E-mail: takeda@nnumse.nagoya-u.ac.jp

専門:半導体材料学 「略歴]

1977年3月京都大学大学院工学研究科博士課程単位取得退 学,工学博士。1977年4月京都大学助手,1986年11月京都大 学講師,助教授,1991年4月名古屋大学教授,2007年4月名 古屋大学小型シンクロトロン光研究センター長。

山根 隆

名古屋大学大学院工学研究科・教授 E-mail: yamane@nubio.nagoya-u.ac.jp 専門:構造生物学、タンパク質構造科学

[略歴]

1972年8月大阪大学大学院理学研究科博士課程中退,理学博 士。1972年9月大阪大学助手,1974年8月名古屋大学助手, 1986年7月名古屋大学助教授,1996年4月より現職。

曽田一雄

名古屋大学大学院工学研究科•教授 E-mail: j45880a@nucc.cc.nagoya-u.ac.jp 専門:光物性

[略歴]

1982年名古屋大学大学院工学研究科博士課程修了,工学博士。 1982年東京大学物性研究所軌道放射物性部門助手。1991年大 阪府立大学工学部講師,1994年名古屋大学大学院工学研究科 助教授を経て現在,同教授。

Central Japan Synchrotron Radiation Research Facility Project

Yoshifumi TAKASHIMA^{1,2}, Masahiro KATOH^{3,1}, Nobuhisa WATANABE^{1,2}, Masahito HOSAKA^{1,2}, Yoshikazu TAKEDA^{1,2}, Takashi YAMANE², Kazuo SODA²

¹Synchrotron Radiation Research Center, Nagoya University, Furo-cho, Chikusaku, Nagoya 464–8603, Japan ²Graduate School of Engineering, Nagoya University, Furo-cho, Chikusaku, Nagoya 464–8603, Japan ³UVSOR, Institute for Molecular Science, 38 Nishigo-naka, Myodaiji, Okazaki 444–8585, Japan

Abstract Nagoya University has proposed a project of a new small synchrotron radiation facility for hard X-rays since 1991. The key equipment of the facility is a compact electron storage ring which can supply hard X-rays. The specifications of the project are as follows: the energy of the stored electron beam is 1.2 GeV, the circumference 62.4 m, and natural emittance 53 nm-rad. The configuration of the storage ring is based on the triple bend cell with twelve bending magnets. Eight of them are normal conducting magnets of 1.4 T, while four of them are superconducting ones (superbends) of 5 T. The bending angle of the superbend is 12 degrees and two or three hard X-ray beamlines can be constructed for each superbend. The electron beam is injected from a booster synchrotron with the energy of 1.2 GeV as full energy injection for the top-up operation. A 50 MeV linac is used as an injector to the booster synchrotron. The project has now developed to "Central Japan Synchrotron Radiation Research Facility" as the principal facility of the project of Aichi prefecture "Knowledge Hub" to establish a new research center for technological innovation.